

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-506451(P2005-506451A)

【公表日】平成17年3月3日(2005.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2005-009

【出願番号】特願2003-538419(P2003-538419)

【国際特許分類】

**C 2 2 C 32/00 (2006.01)**

**A 0 1 L 3/00 (2006.01)**

**C 2 2 C 29/16 (2006.01)**

**G 1 1 B 5/73 (2006.01)**

**G 1 1 B 21/02 (2006.01)**

【F I】

C 2 2 C 32/00 Q

C 2 2 C 32/00 H

C 2 2 C 32/00 V

A 0 1 L 3/00

C 2 2 C 29/16 Z

G 1 1 B 5/73

G 1 1 B 21/02 6 0 1 A

【手続補正書】

【提出日】平成17年9月12日(2005.9.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属マトリックス複合体からなるメモリディスク基板であって、該金属マトリックス複合体において、セラミックス材料の粒子が金属中0.1～80重量%の範囲で該金属中に存在し、該金属がアルミニウム、マグネシウム、チタンおよびこれらの混合物からなる群から選択され、該セラミックス粒子が六ホウ化ケイ素、六ホウ化カルシウム、四ホウ化ケイ素、四ホウ化カルシウムおよびこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とするメモリディスク基板。

【請求項2】

前記セラミックス粒子が、0.1～200ミクロンの平均粒径を有する請求項1に記載のメモリディスク基板。

【請求項3】

前記金属がアルミニウムである請求項1または2に記載のメモリディスク基板。

【請求項4】

前記セラミック粒子が、六ホウ化ケイ素の粒子と六ホウ化カルシウムの粒子の混合物である請求項1、2または3に記載のメモリディスク基板。

【請求項5】

前記六ホウ化ケイ素の粒子が、0.1～200ミクロンの平均粒径を有する請求項4に記載のメモリディスク基板。

【請求項6】

前記金属マトリックス複合体が、10ミクロンの平均粒径を有するセラミック粒子を40重量%未満含み、前記金属マトリックス複合体の残りがアルミニウム金属である請求項3に記載のメモリディスク基板。

【請求項7】

前記金属マトリックス複合体材料が、前記複合体材料の1重量%～50重量%の範囲にあるセラミック材料を含む請求項1に記載のメモリディスク基板。

【請求項8】

前記セラミック材料が、約1マイクロメートル～500マイクロメートルの範囲の粒径を有する請求項7に記載のメモリディスク基板。

【請求項9】

前記ディスクが、70～180GPaの範囲の弾性率を有する請求項1に記載のメモリディスク基板。

【請求項10】

前記ディスクが、2.6～2.9グラム/ｃ<sup>3</sup>の範囲の密度を有する請求項1に記載のメモリディスク基板。

【請求項11】

前記複合体材料が、25～75GPa/g/ｃ<sup>3</sup>の範囲の比弾性率を有する請求項1に記載のメモリディスク基板。

【請求項12】

前記複合体材料が、8.9～21.5ppm/Kの範囲の熱膨張係数を有する請求項1に記載のメモリディスク基板。

【請求項13】

請求項1に記載のディスクと、  
該ディスクの外側表面を全体に被覆するアモルファス材料の層と、  
からなるメモリディスク基板。

【請求項14】

前記アモルファス層がニッケル-リンからなる請求項13に記載のメモリディスク基板。  
。